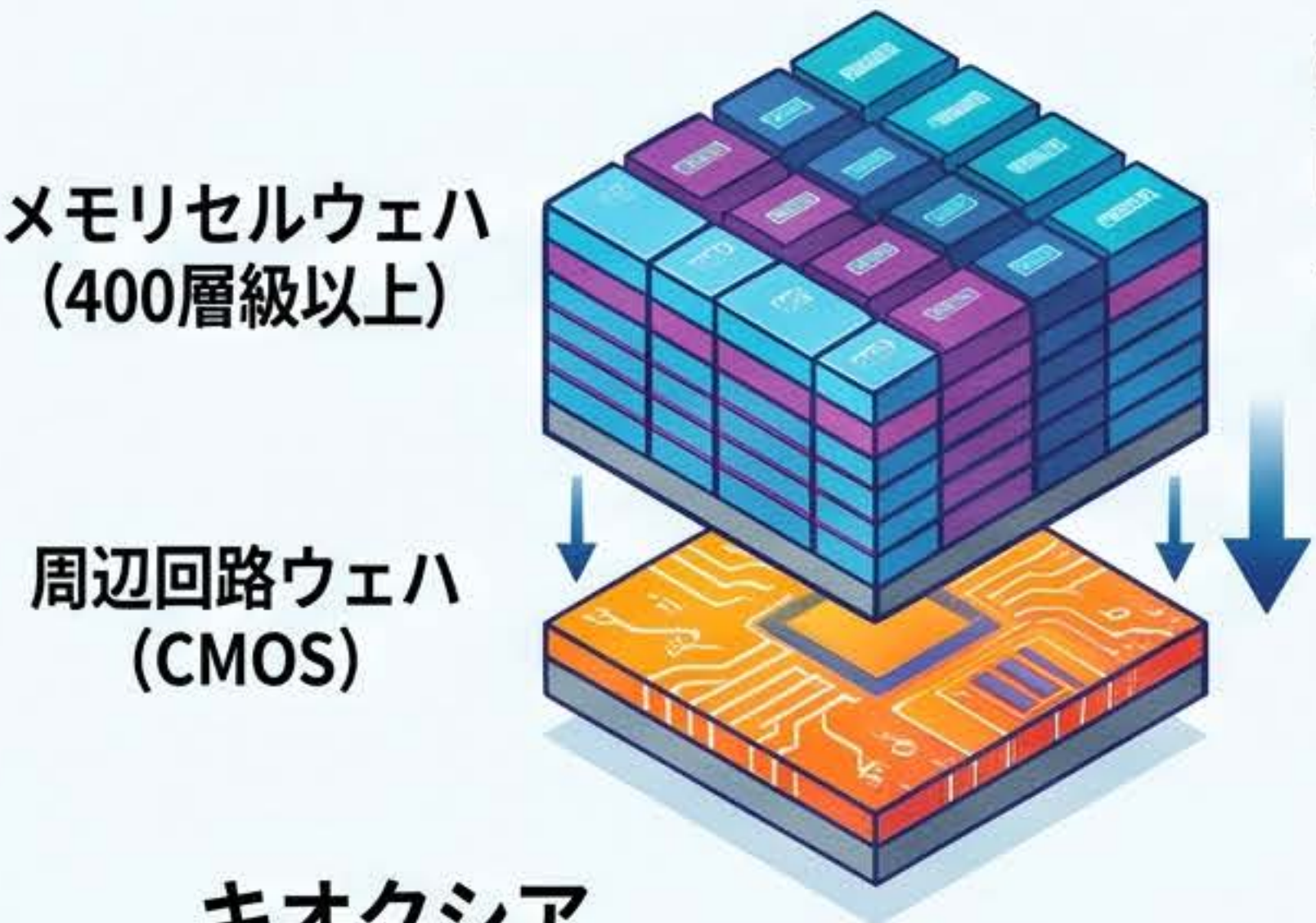
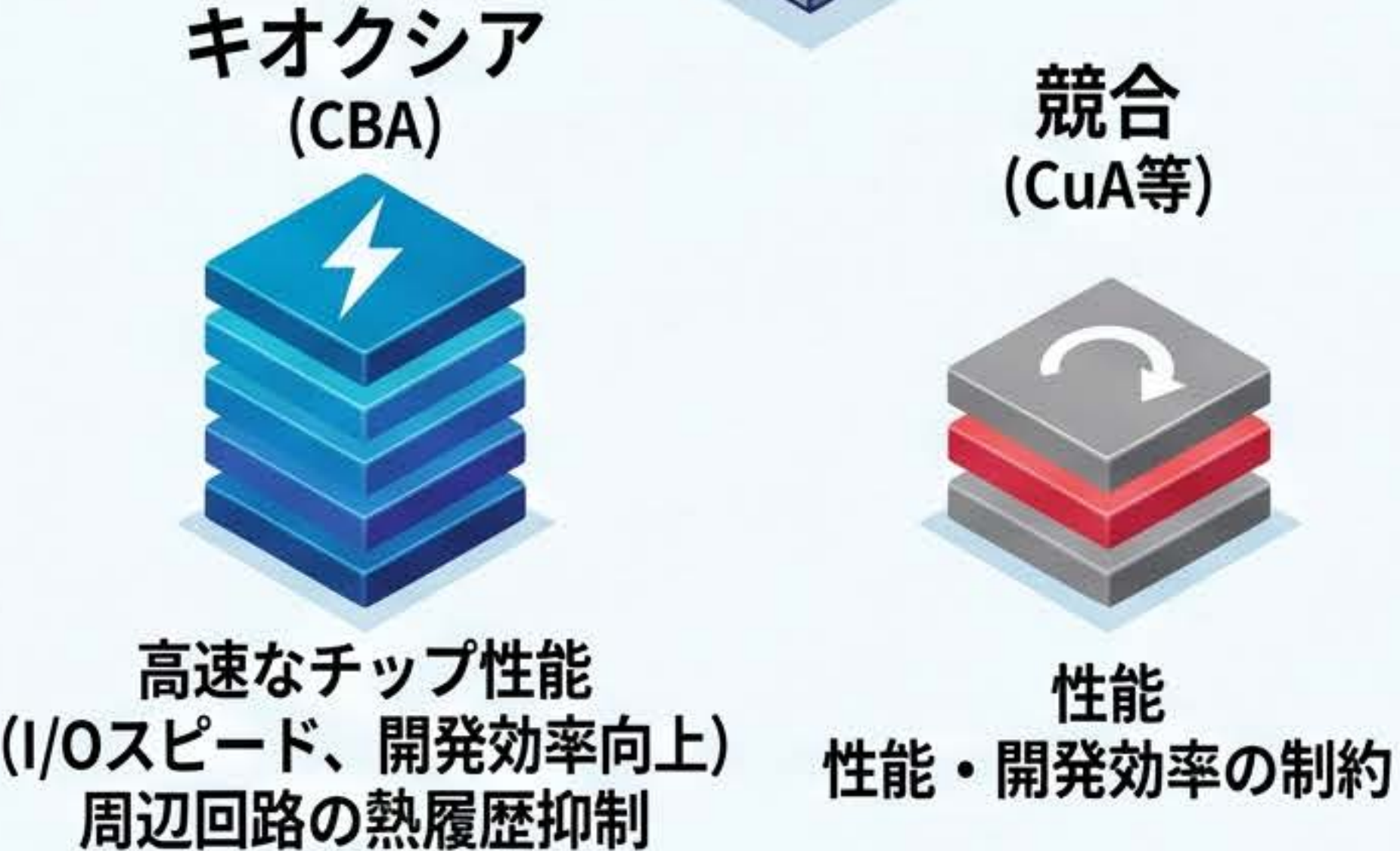


キオクシアの技術・市場戦略：3D NANDの進化と次世代メモリへの布石

3D NANDの高度化とCBA技術



CBA (CMOS directly Bonded to Array) 技術：
セルと周辺回路を別ウェハで最適化して接合し、高積層化を可能にする。

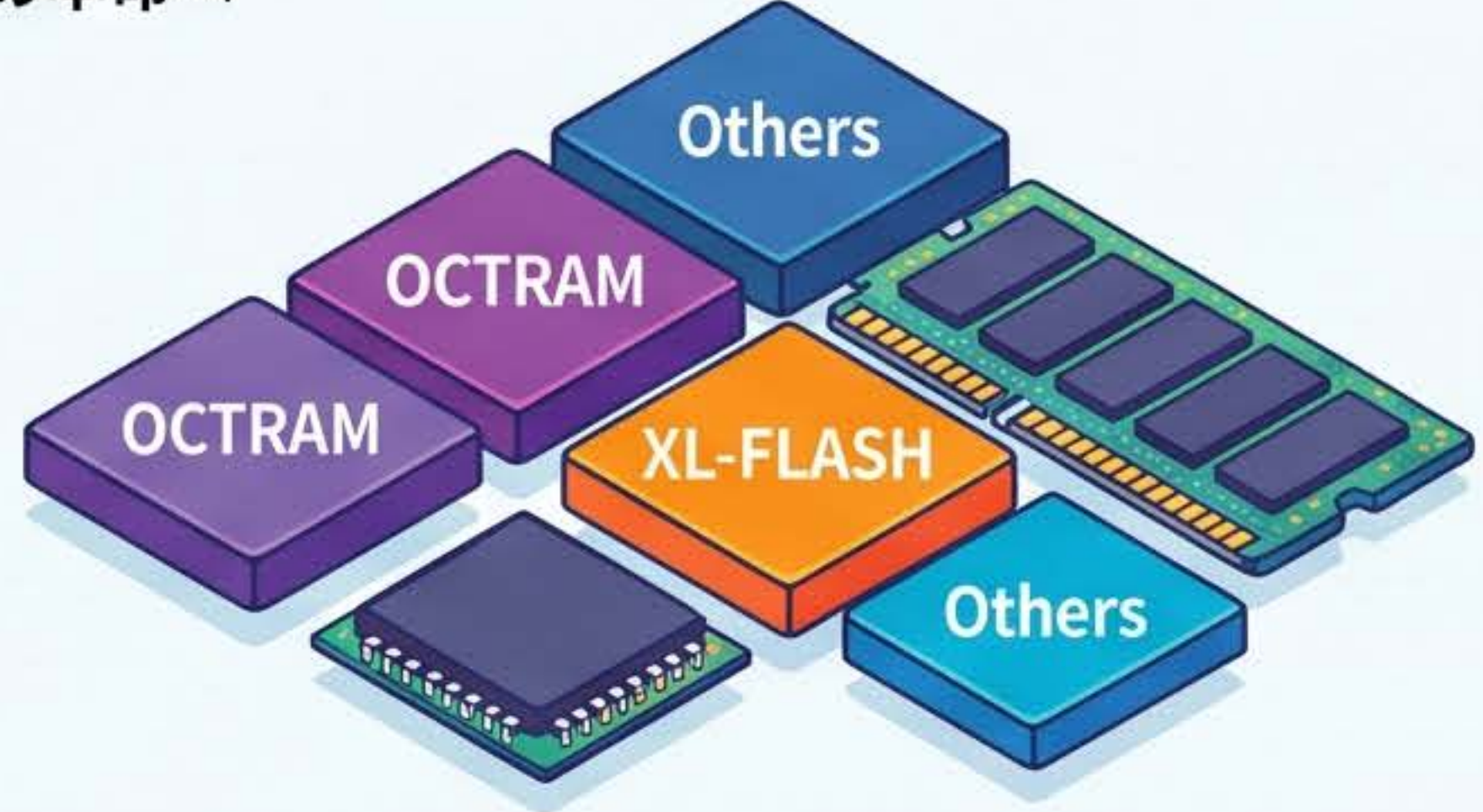
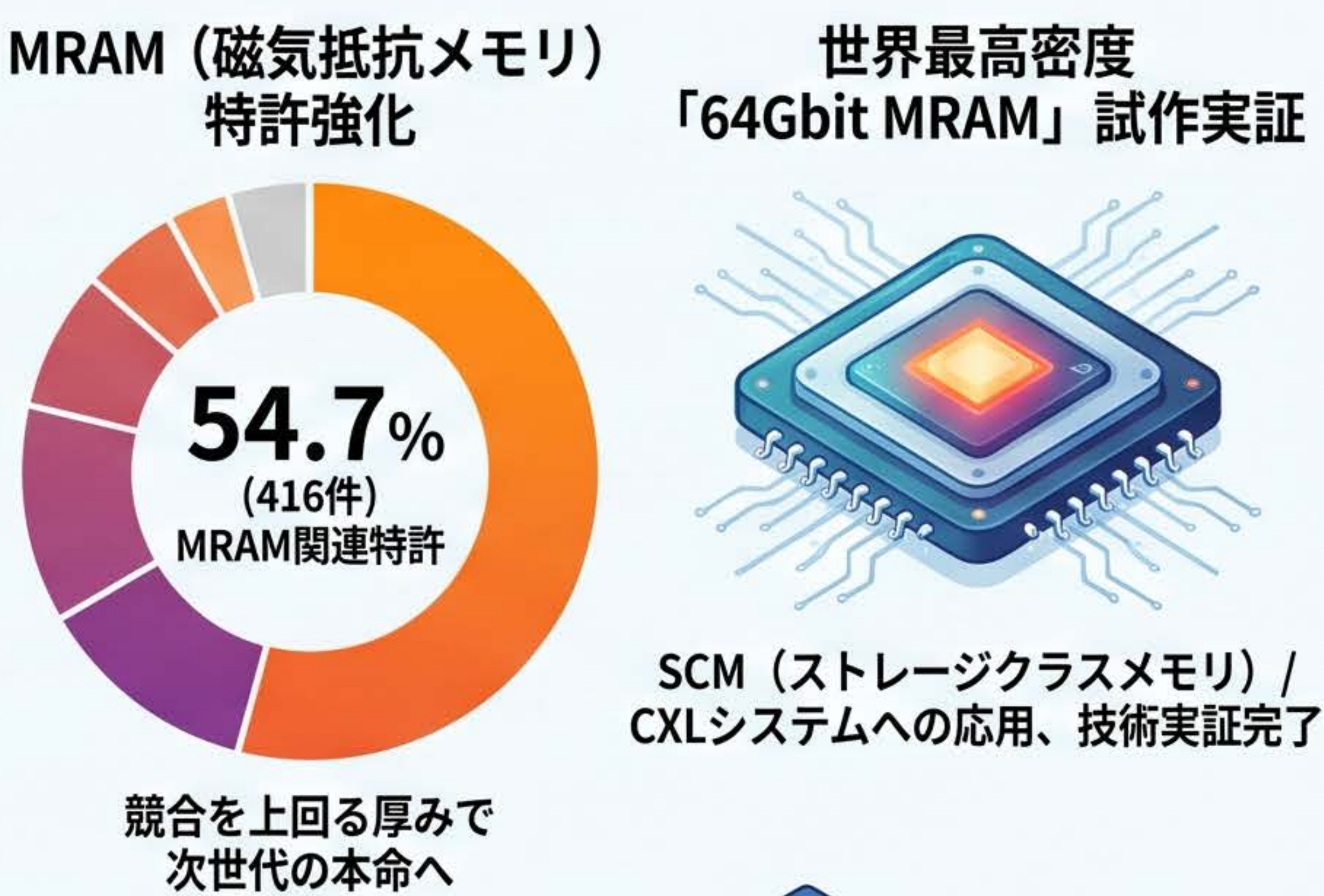


332層 (BiCS10) 量産，
次世代1000層超 (Multi-stack CBA) 視野



評価軸	キオクシア	Samsung	YMTC (長江存儲)
最新量産層数	332層 (BiCS10)	400層 (V10)	400層
ウェハ接合技術	CBA ★	CuA	Xtacking
次世代MRAM特許	最強 ★★	強 (eMRAM量産)	極弱

次世代メモリへの布石と特許戦略



多角的なメモリ階層オプション
(AI時代の多様なニーズ)

酸化物半導体DRAM (OCTRAM) や低遅延フラッシュ
(XL-FLASH) など、AI時代の多様なニーズに応える
ポートフォリオ構築中